



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H5401

对应国外型号
2N5401

主要用途

作电话机、高反压放大。(与 H5551 互补)

极限值 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150 $^{\circ}\text{C}$
T_j ——结温	150 $^{\circ}\text{C}$
P_C ——集电极耗散功率	625mW
V_{CBO} ——集电极—基极电压	-160V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	-150V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	-5V
I_C ——集电极电流	-600mA

外形图及引脚排列

TO-92



1—发射极, E
2—基 极, B
3—集电极, C

电参数 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-0.05	μA	$V_{\text{CB}}=-120\text{V}$, $I_{\text{E}}=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-0.05	μA	$V_{\text{EB}}=-3\text{V}$, $I_{\text{C}}=0$
H_{FE}	直流电流增益	30 60 50		280		$V_{\text{CE}}=-5\text{V}$, $I_{\text{C}}=-1\text{mA}$ $V_{\text{CE}}=-5\text{V}$, $I_{\text{C}}=-10\text{mA}$ $V_{\text{CE}}=-5\text{V}$, $I_{\text{C}}=-50\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			-0.2 -0.5	V	$I_{\text{C}}=-10\text{mA}$, $I_{\text{B}}=-1\text{mA}$ $I_{\text{C}}=-50\text{mA}$, $I_{\text{B}}=-5\text{mA}$
$V_{\text{BE(sat)}}$	基极—发射极饱和电压			-1 -1	V	$I_{\text{C}}=-10\text{mA}$, $I_{\text{B}}=-1\text{mA}$ $I_{\text{C}}=-50\text{mA}$, $I_{\text{B}}=-5\text{mA}$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	-160			V	$I_{\text{C}}=-100\mu\text{A}$, $I_{\text{E}}=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-150			V	$I_{\text{C}}=-1\text{mA}$, $I_{\text{B}}=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	$I_{\text{E}}=-10\mu\text{A}$, $I_{\text{C}}=0$
f_{T}	特征频率	100		400	MHz	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_{\text{C}}=-10\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$